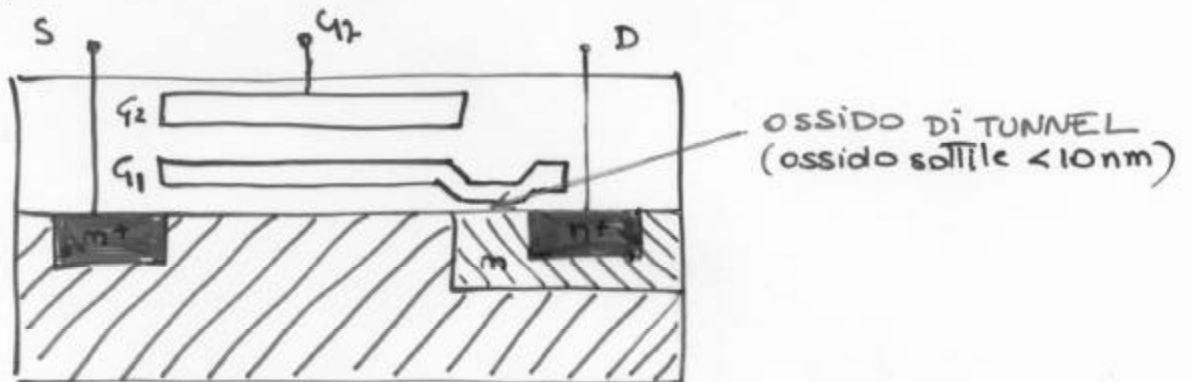


* MEMORIE EEPROM (E²PROM - ELECTRICALLY ERASABLE PROM)

- Singole informazioni immagazzinate possono essere SINGOLARMENTE cancellate.
- Si basano su dispositivi a doppio gate simili a quelli delle EPROM



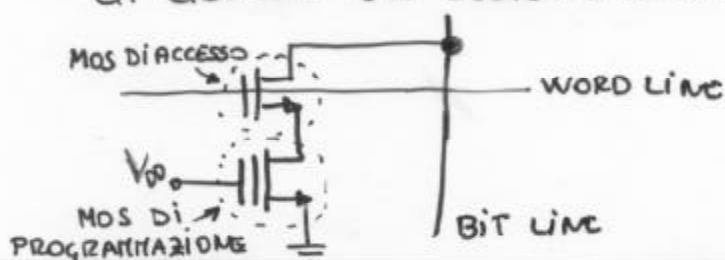
→ PROGRAMMAZIONE

- Tensione positiva data al gate $G_2 \Rightarrow$ gli elettroni del drain possono passare attraverso l'ossido di tunnel e depositarsi su G_2
- ↓
- il MOS è interdetto per le normali tensioni di esercizio

→ CANCELLAZIONE

- è applicata una tensione negativa al gate $G_2 \Rightarrow$ per effetto Tunnel gli elettroni passano dal gate G_1 al drain ripristinando l'operatività normale del MOS e cancellando la memoria

RISCHIO: se il FLOATING GATE G_2 è scaricato eccessivamente \Rightarrow sul floating gate appare carica positiva che rende il MOS sempre conduttivo (si forma il canale di elettroni tra source e drain) \Rightarrow MOS DI ACCESSO



che si comporta da interruttore.